

## 要 約 書

半導体装置は、不揮発性メモリトランジスタ１００を有する。不揮発性メモリトランジスタ１００が形成された半導体層１０の上に、層間絶縁層４０が設けられている。層間絶縁層４０は、不揮発性メモリトランジスタと、半導体層１０の上方に形成された導電層３０とを電氣的に分離するための絶縁層であり、窒化物を含む層４２を含む。

20200929 092702